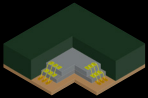
BGA (UTCSP)

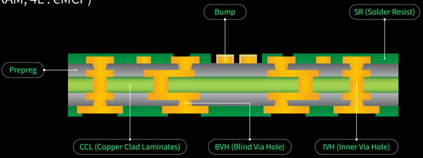
개요 OVERVIEW

Wire Bonding으로 반도체 칩을 연결하는 패키지 기판

130µm 이하 박판 구조 (3L : 모바일 DRAM, 4L : eMCP)

- 응용분야 : 모바일용 메모리 패키지

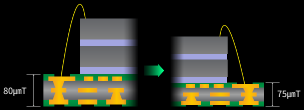




핵심 기술 CORE TECHNOLOGY

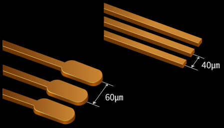
박형 Coreless 기판 개발

- 두께 축소 및 강성 확보



미세회로 개발 (mSAP공법)

- Bond Finger 미세화



주요 사양 KEY SPECIFICATIONS

기판 두께 (3L/4L)	75µm / 100µm
Bond Finger Pitch	60µm
회로 (Line/Space)	20µm / 20µm